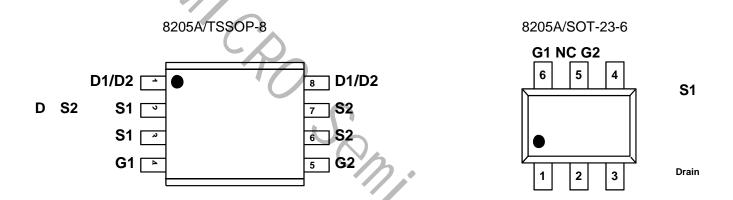
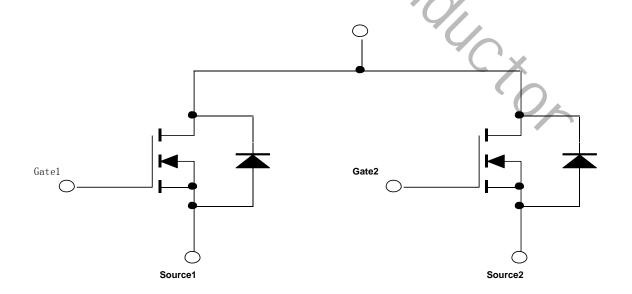


特点

- ◆ 低导通电阻高密度超低电阻设计
- ◆ 2.5V 栅极驱动
- ◆ 低驱动电流
- ◆ 理想的锂电池保护应用
- ◆ 封装形式: TSSOP-8/SOT-23-6



N-Channel MOSFET





最大额定值和热特性 (Ta = 25℃,除非另有说明。)

参数	符号	值	单位	
漏源电压	V _{DS}	20		
栅源电压	Vgs	±12	V	
连续漏电流, VS@4.5V	Id @TA=25℃	6	Δ.	
漏极脉冲电流	IDM	20	A	
TA ≠ 25°C		2		
最大功耗 TA = 7 5℃	P_{D}	1.3	W	
工作结温和存储温度范围	TJ, Tstg	-55 to 150	$^{\circ}$	
结环热阻(PCB 安装)	R ө да	62. 5	°C/W	

注: 重复性极限值: 脉冲宽度由最高结温限制。

电特性

. (14) Tr						
参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
静电		0	<u></u>			
漏源击穿电压	BVDSS	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 250uA$	20			V
		$V_{GS} = 1.8V, I_{D} = 2.0A$	4	53. 0	75. 0	
漏源电阻	R _{DS} (on)	$V_{GS} = 2.5V, I_{D} = 3.5A$		30.0	38. 0	mΩ
		$V_{GS} = 4.5V, I_{D} = 4.5A$		22. 0	28. 0	
栅极阈值电压	V _{GS} (th)	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_{D} = 250uA$	0. 5		1.5	V
栅源短路时漏极电 流	IDSS	$V_{DS} = 20V$, $V_{GS} = 0V$			1	uA
漏极短路时截止栅 电流	Igss	$V_{GS} = \pm 12V$, $I_D=0$ uA			±100	nA
跨导	g_{fs}	$V_{DS} = 15V, I_{D} = 6.0A$		29		S
动态						
总栅极电荷	Q_{g}	$V_{DS} = 10V, I_{D} = 6A$		6. 24	8. 11	nC



栅源电荷	Qgs	V _{GS} = 4.5V		1.64	2.13		
栅漏电荷	Q _{gd}			1.34	1.74		
延迟时间(On)	t _{d(on)}			10.4	20.8		
上升时间(On)	t _r	$V_{DD} = 10V, I_{D} = 6A$ $I_{D} = 1A, V_{GS} = 4.5V$		4.4	8.8		
延迟时间(Off)	t _{d(off)}			27.36	54.72	ns	
下降时间(Off)	t _f			4.16	8.32		
输入电容	C _{iss}			522.3			
输出电容	Coss	V _{DS} = 8V, V _{GS} = 0V f=1.0MHz		98.48		pF	
反向传输电容	C _{rss}			74.69			
漏源二极管							
二极管最大正向电流	ls				1.7	Α	
二极管正向电压	V _{SD}	I _S = 1.7A, V _{GS} = 0V			1.2	V	

注: 脉冲测试: 脉冲宽度<=300us, 占空比<=2%

